

(19) (KR)
 (12) (A)

(51) 。 Int. Cl. 7
 H05B 33/10 (11) 2001 - 0062654
 (43) 2001 07 07

(21) 10 - 2000 - 0081088
 (22) 2000 12 23

(30) 1999 - 367123 1999 12 24 (JP)

(71) 가 가
 2 5 5

(72) 3 112 - 3

17 - 1 - 601

1495 - 6

(74)

:

(54) , ,

가
 EL ,
 Si Si (100) SiO₂ (101) , M SiO₂ (101) , SiO₂
 (100) (100) KOH (110) M (140) (104) ,
 (100) . , Si .

EL , ,

1 1

2 Si

3

4 2

5 EL

6 EL

7 EL

8

9

< >

1R :

1G :

1B :

10 :

30 : 1 TFT

40 : 2 TFT

51 :

52 :

53 :

54 :

61R :

61G :

61B :

100 : (Si)

101 :

110 :

140 :

M :

, (Electro Luminescence : , 「EL」 .)

EL

, EL EL 가, CRT LCD .

, EL (Thin Film Transistor : , 「EL」 .)
EL

5 EL , 6 (b) 5 E - E , 6 (a) 5 D - D

5 , (51) 1 TFT(30) 가 (52) , TFT(30) 가
(54) (55) EL (60) (61) (11s) 2 TFT(40) (4
3) 2 TFT (41s) (53) , , , (41d)
EL (60), TFT , (51) (54) (11s) (55)
(54) , , (12) TFT (43) 가
, 2 TFT(40) (43) (55)6 , EL ,
(10) , TFT , EL

, TFT 1 TFT(30)

6 (a) , , (10) , CVD

8

, , , ,

6

, (10) 2 TFT(40) (61R)

, , (Ni)
 , (10) (61R)
 , (130) .

9 , TFT

(110) , (95) 가, 8 (125) (10)
 (95) 가 (95) (125) 4 (10) (95) (95)
 , , , (95) (120) . , (12)
 6) , (95)

, , (110) 가 (95) , ,
 (61) 가 , EL , , , ,

, (95) (110) (95) 가 , , Ni
 가 , (110) 가 가 , , 100 μ m ± 10 μ m

, Ni 가 (95) (95) (95) , Ni , ,
 , , , , , ,

, , , , , ,
 가 , , , , , ,

, , , , , ,
 , , , , , ,
 EL

, , , , , ,
 , , , , , ,
 가

1 , TFT (10) , (Si)
 (140) (100) , (100)
 (100) (100) .
 , (100) (110) 가 . 1 , 7
 1R, 1G, 1B) 가 , (110)
) (61R)

, , 가 , 가 ,
, , EL

Si 가 M

◀ 2 ▶

2

4 (a)
4 (b) 4 (a) C - C

4 2 가 1

「用」가

Si (100) . 2 a

mm

Si (100) , 2 a , 400

4 (a) , , (140)가
· , M (140)가 . ,
Si

, 1 M , KOH , 가 SF₆

가 . . , 가 . . , 1

, , 7 ,

가 , ,

가

가

EL

Ni

가 , , , 가

, , ,
52 x 222 , .

, 가 , EL

(57)

1.

(基體)

가

2.

1

3.

1

1

1

2

2

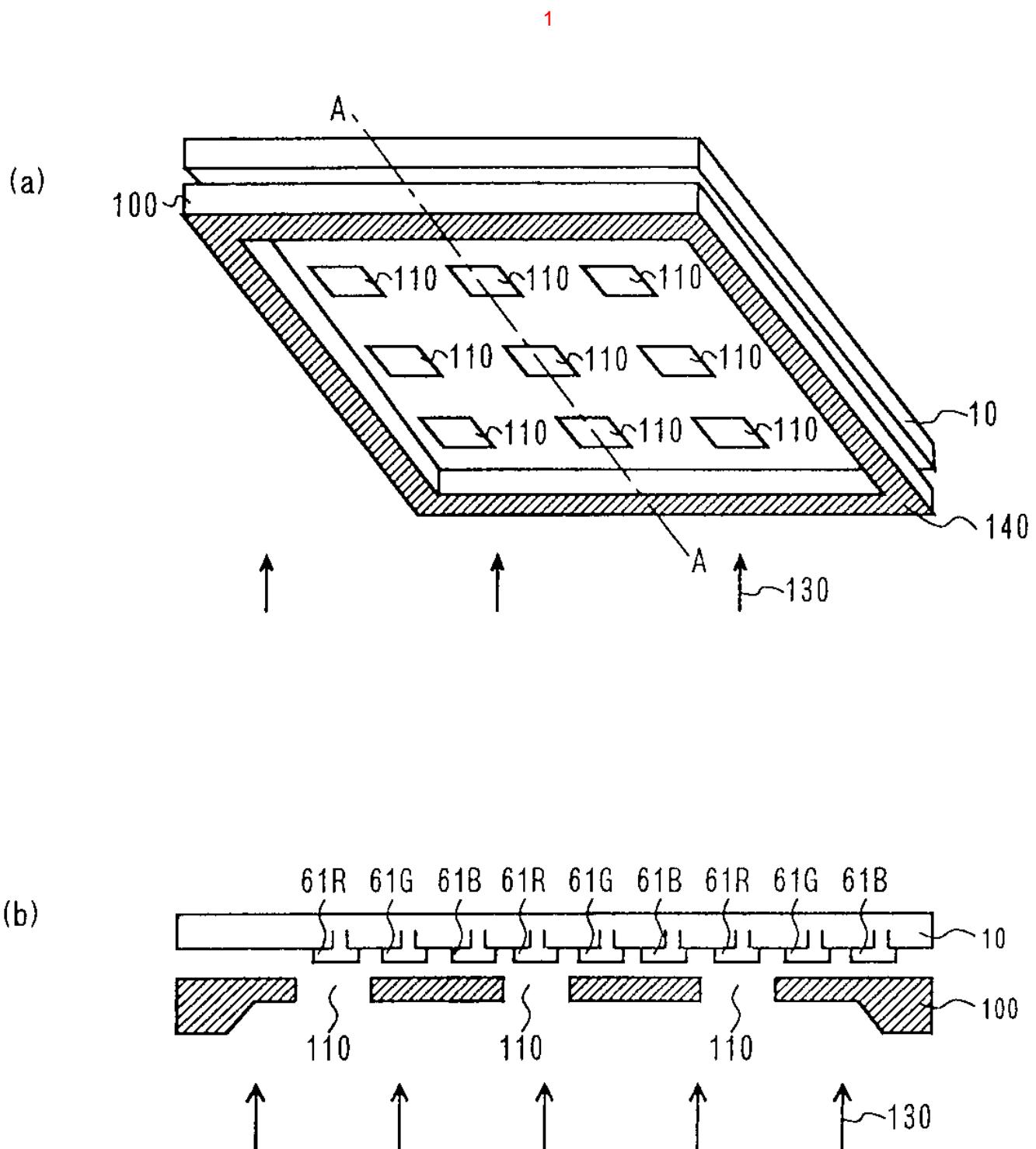
4.

3

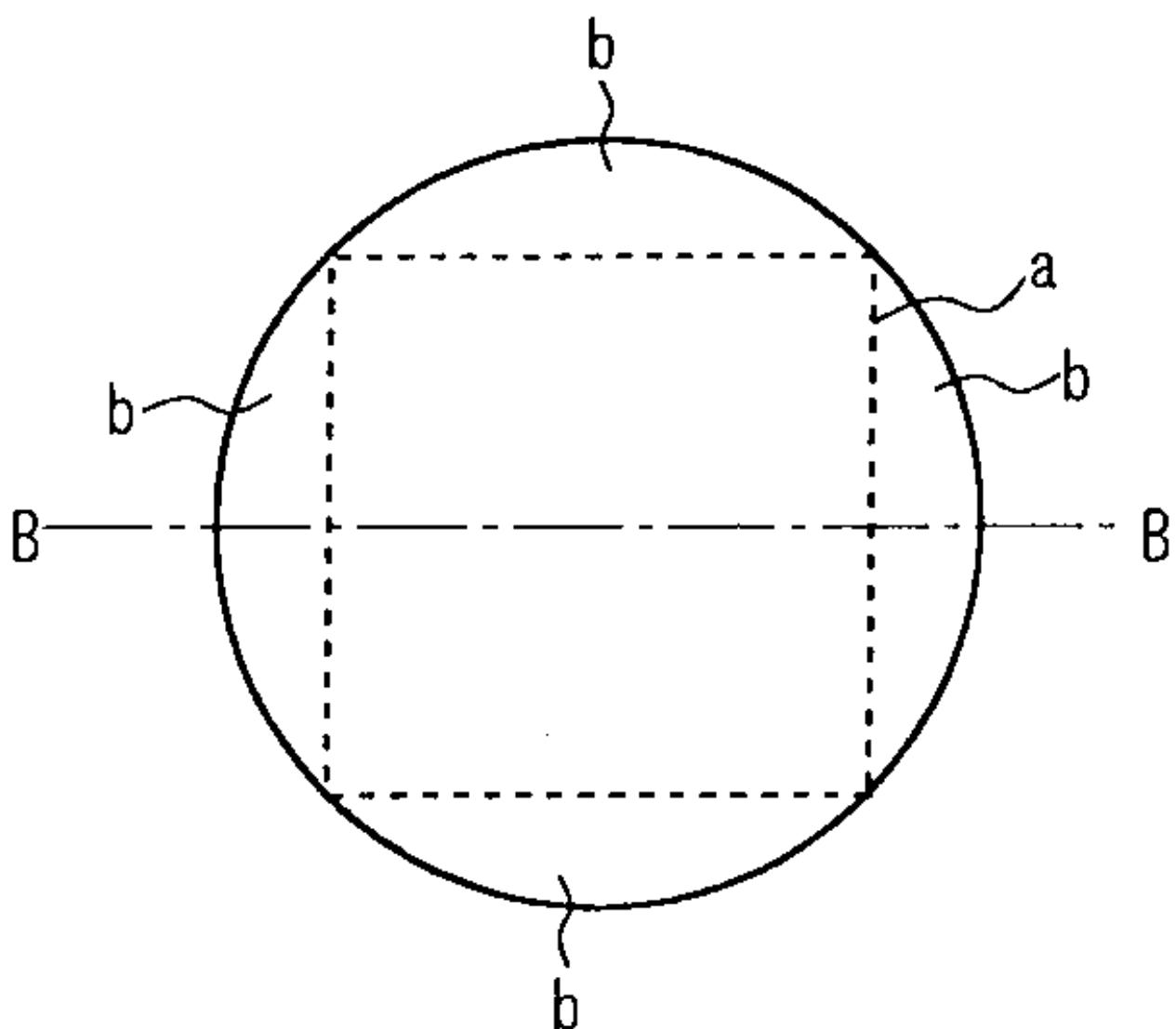
5.

6.

5

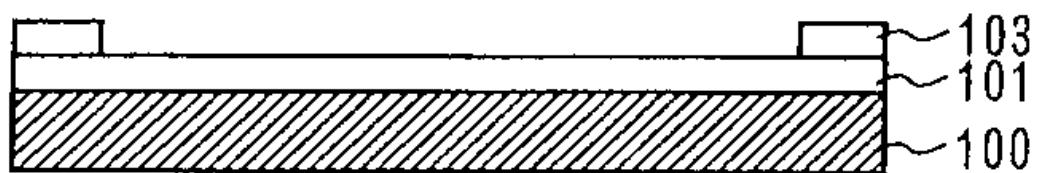


2



3

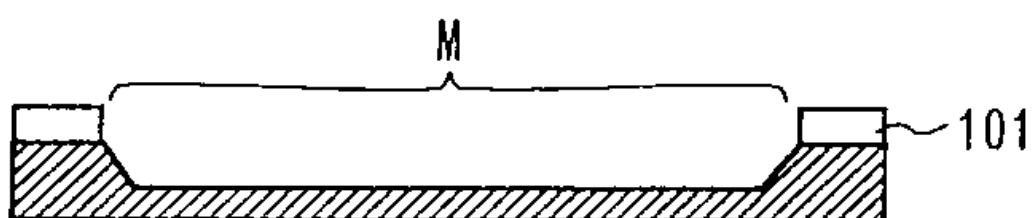
(a)



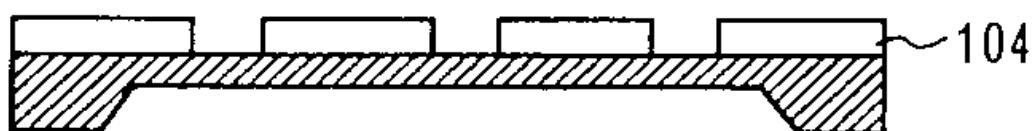
(b)



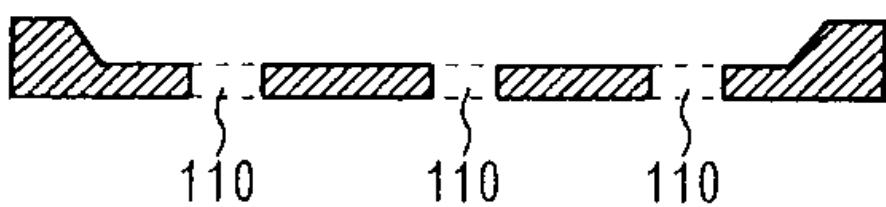
(c)



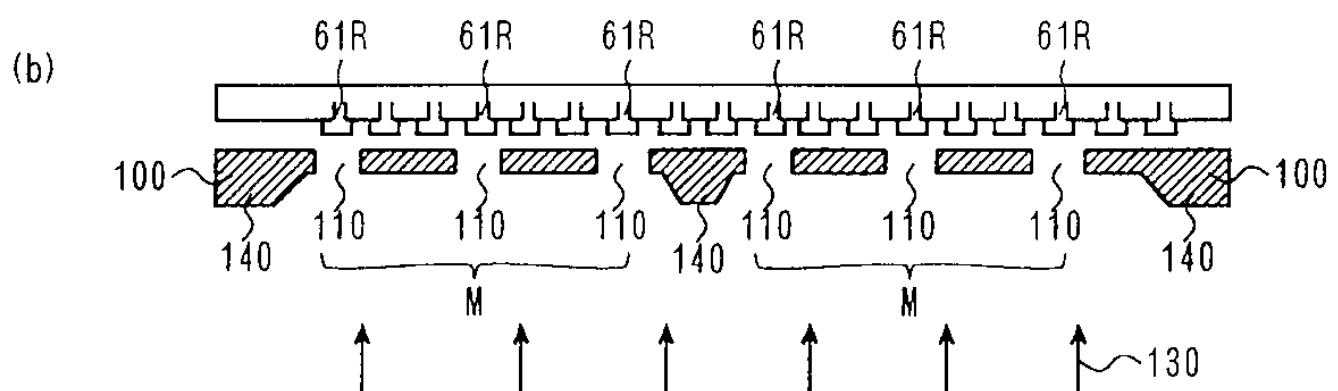
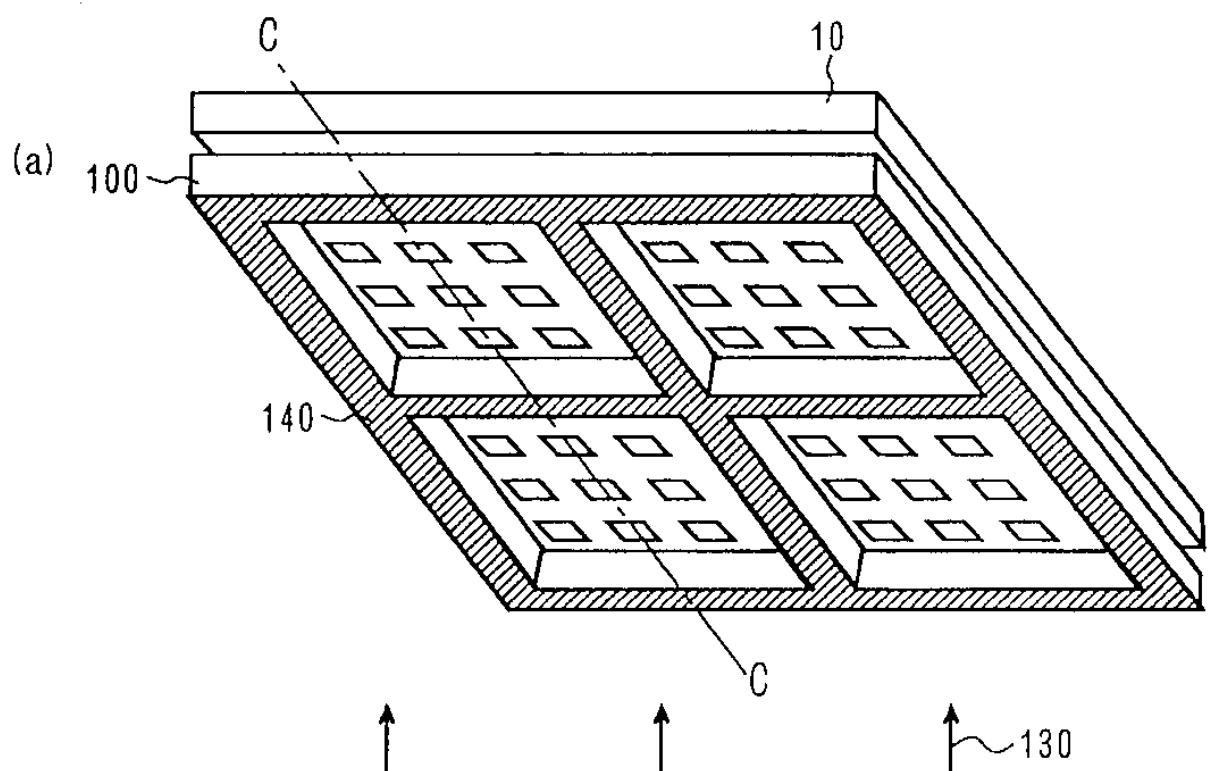
(d)



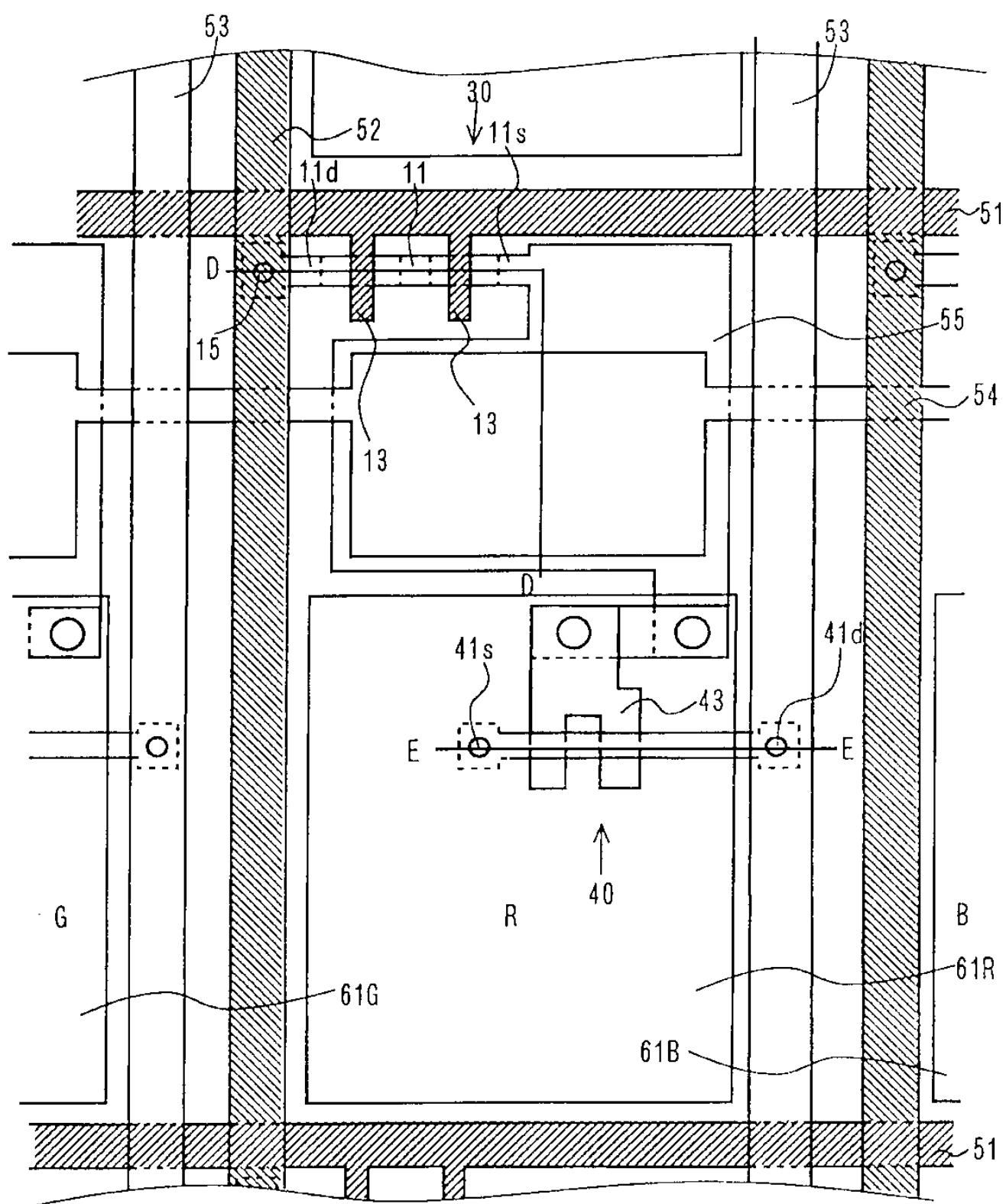
(e)



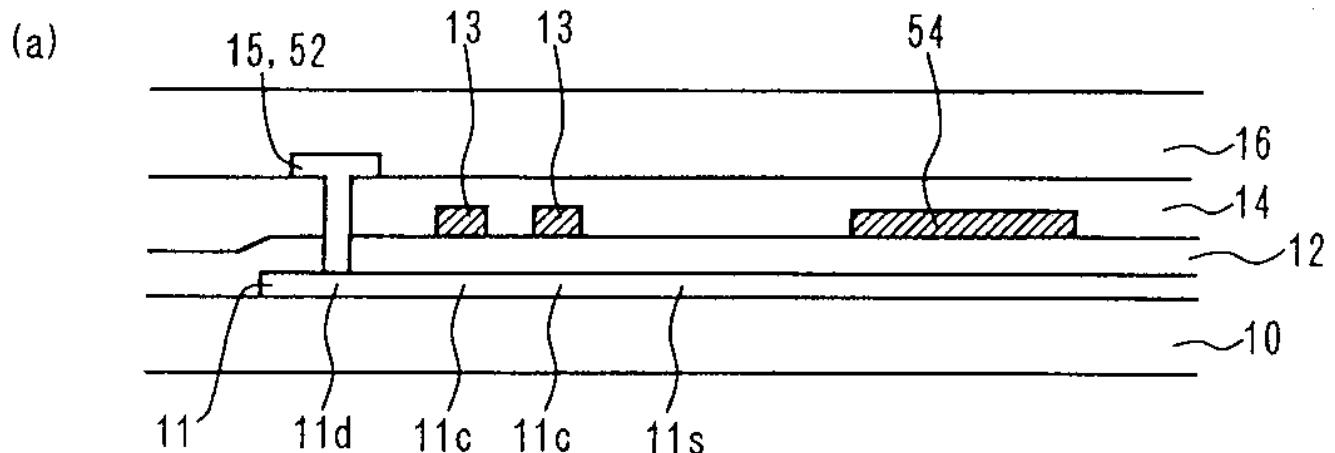
4



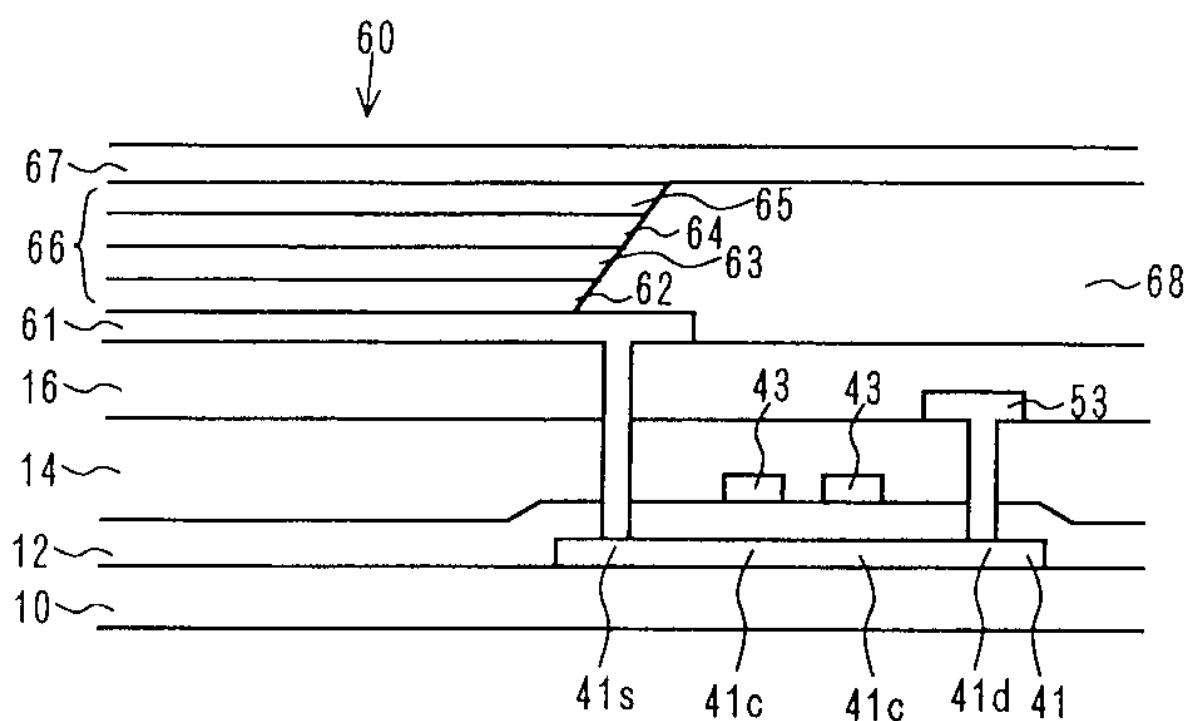
5



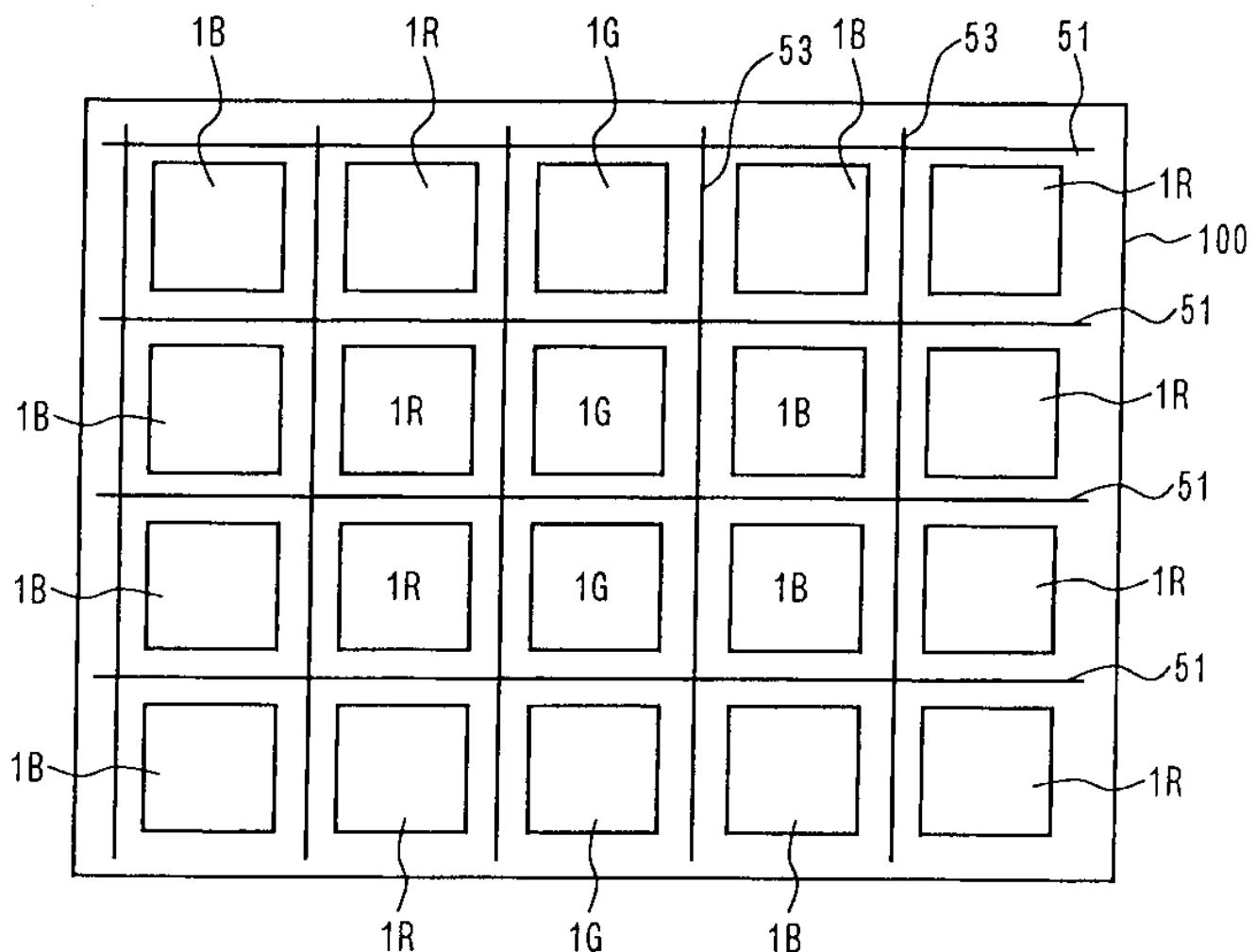
6



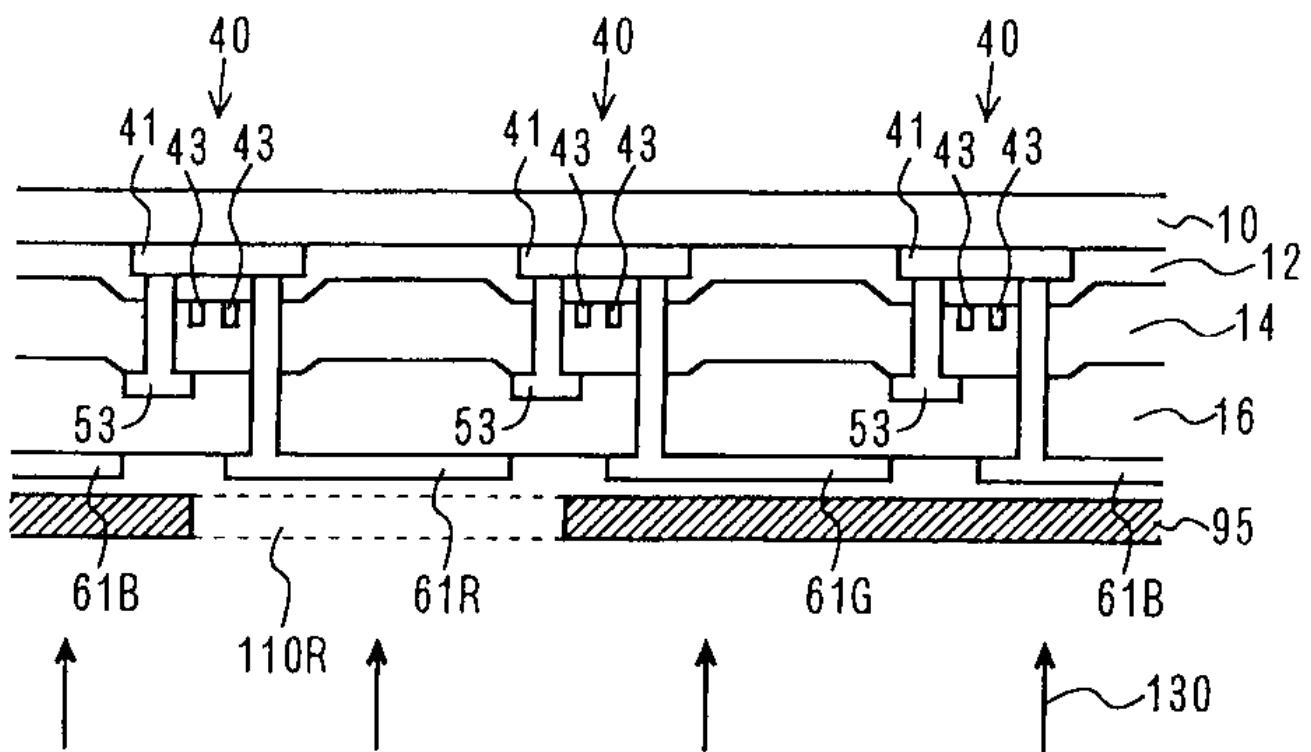
(b)



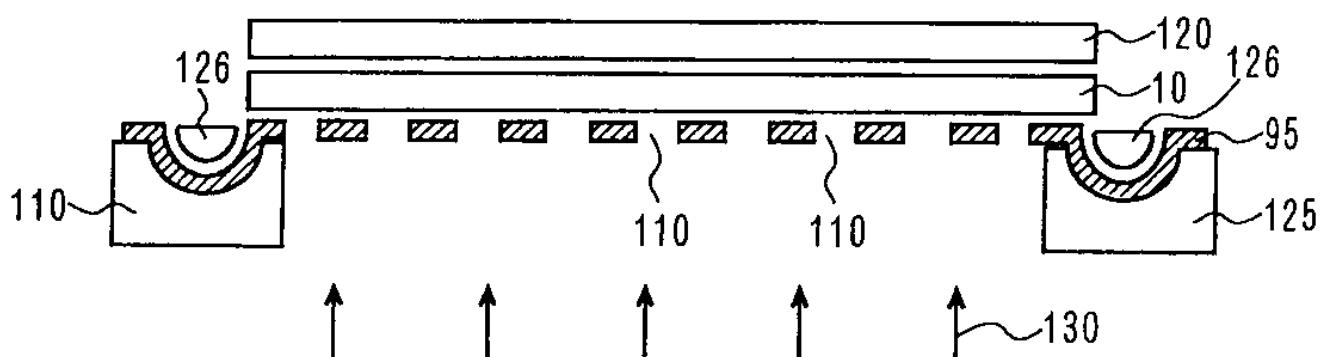
7



8



9



专利名称(译)	磨损掩模，其制造方法，电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020010062654A	公开(公告)日	2001-07-07
申请号	KR1020000081088	申请日	2000-12-23
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社 山洋电气株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
[标]发明人	YAMADA TSUTOMU 야마다쓰또무 MORIMOTO YOSHIHIRO 모리모또요시히로 YONEDA KIYOSHI 요네다기요시		
发明人	야마다쓰또무 모리모또요시히로 요네다기요시		
IPC分类号	H01L51/50 H01L51/00 G09F9/30 H05B33/10 H05B33/14 H01L21/285 H01L27/32 G09F C23C G09F9/00 H05B H05B33/12 H01L27/28 H01L C23C14/04		
CPC分类号	H01L51/56 H01L27/3244 H01L51/0011		
代理人(译)	CHANG, SOO KIL CHU, 晟敏		
优先权	1999367123 1999-12-24 JP		
其他公开文献	KR100496577B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明的目的是提供一种电致发光显示装置，其中精确度获得用于沉积的良好掩模，使用用于沉积的掩模将有机材料层叠在固定位置。在掩模层M中形成开口部分(110)的图案的抗蚀剂图案(104)，SiO₂膜(101)形成在方形的Si衬底(100)上，并且SiO₂膜(101)是留在基板上并决定掩模，并将Si衬底(100)蚀刻到蚀刻剂KOH上，形成掩模层M和阶梯部分(140)并再次进行蚀刻并且形成用于沉积的掩模(100)。像这样，可以获得包括作为盒子的Si衬底的精度，用于沉积的良好掩模。电致发光单元，用于沉积的掩模和像素。

